

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
3 juin 2004 (03.06.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2004/046791 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷ : G02C 7/02,
G02B 1/10

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2003/003334

(22) Date de dépôt international :
7 novembre 2003 (07.11.2003)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
02/14356 15 novembre 2002 (15.11.2002) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :
ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GEN-
ERALE D'OPTIQUE) [FR/FR]; 147, rue de Paris,
F-94220 Charenton le Pont (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : CONTE,
Dominique [FR/FR]; 99, rue des Clefmonts, F-52100
SAINT-DIZIER (FR). KELLER, Gerhard [DE/FR]; 37
bis, avenue Miss Cavell, F-94100 ST Maur des Fosses
(FR). WILLEMIN, Gérard [FR/FR]; 5, rue Etienne
Brulé, F-94500 Champigny Sur Marne (FR).

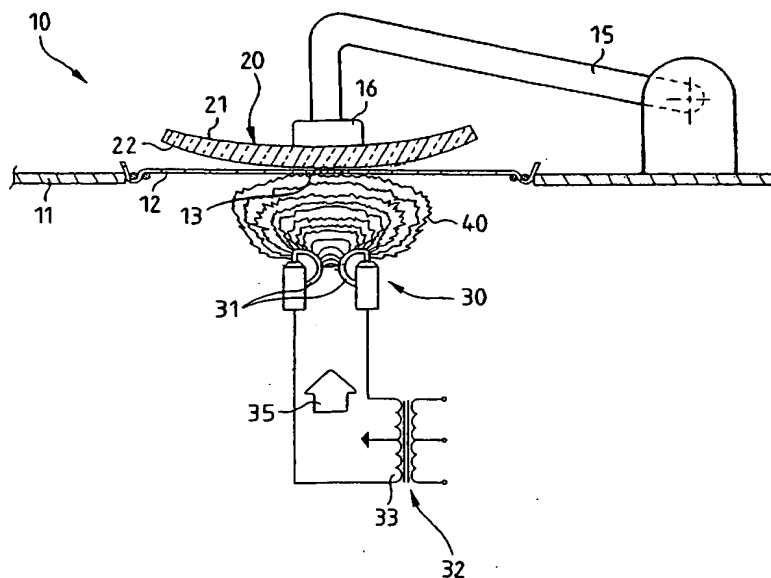
(74) Mandataire : SANTARELLI; 14, avenue de la Grande-
Armée, B.P. 237, F-75822 Paris Cedex 17 (FR).

(81) États désignés (national) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ,
DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH,
GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC,
LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW,
MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC,
SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: METHOD FOR OBTAINING A MARK ON A LOW SURFACE ENERGY OPHTHALMIC LENS

(54) Titre : PROCEDE D'OBTENTION D'UN MARQUAGE SUR UNE LENTILLE OPHTALMIQUE A BASSE ENERGIE DE
SURFACE



(57) Abstract: The invention concerns a method for marking a ophthalmic lens comprising a hydrophobic and/or oil-repellent low surface energy outer layer on a high surface energy substrate or coating. The method consists in: positioning a complementary patterning mask of the desired marking between the lens surface to be marked and an energizing discharge source capable of substantially eliminating the outer layer to as to expose the subjacent high energy substrate or coating. The temporary protective layer has a surface energy higher than that of the outer layer and a thickness less than about 5 nm, and preferably between 2 and 4 nm, thereby enabling the discharge to act on the outer layer through the temporary protective layer.

[Suite sur la page suivante]

WO 2004/046791 A1



(84) États désignés (*régional*) : brevet ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale

— avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(57) **Abrége :** Procédé pour le marquage sur une face de verre ophtalmique du type comportant une couche extérieure hydrophobe et/ou oléophobe à basse énergie de surface sur un substrat ou un revêtement à haute énergie de surface. Un masque de configuration complémentaire du marquage désiré est positionné entre la face du verre à marquer et une source de décharge énergisante apte à éliminer sensiblement la couche extérieure afin de révéler le substrat ou revêtement à haute énergie sous-jacent. La couche protectrice temporaire a une énergie de surface supérieure à celle de la couche extérieure et une épaisseur inférieure à environ 5 nm, et de préférence entre environ 2 et 4 nm, ce qui permet à la décharge d'agir sur la couche extérieure à travers la couche protectrice temporaire.